

Transistoren

Transistors

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp) Si-MOS field-effect transistors (p-channel enhancement-type)

Typ	Grenzdaten max. ratings					bei at		Informationsdaten electrical characteristics					bei at	
	P_{Tot} mW	U_{DS} U_{DB}	U_{GS} U_{DG}	U_{DG}	U_{SB}	$-I_D$ I_{DRM}^*	$-I_D$	Y_{21}	bei at $-U_{DS}$	$-U_T$	bei at $-I_D$	C_{ges} pF	R_{DS} Ω	
	V	V	V	V	mA	mA	mS	V	V	μA	pF	Ω		
SMY 50	225	-31/+0,3	-31/+0,3	± 31	-15/+0,3	25	10	2	10	3 ... 6	10	<12	150	
SMY 51 ¹⁾	240	-31/+0,3	-31/+0,3	± 31	0	20	12	2	10	3 ... 6	10	<12	150	
SMY 52	300	-31/+0,3	-31/+0,3	± 31	-15/+0,3	60	50	12,5	10	3 ... 6	10	<38	35	
SMY 60 ³⁾	240	-25/+0,3	-25/+0,3	± 25	-15/+0,3	20				>2,8	10	<10		
U 105 D ²⁾	400	-31/+0,3	-31/+0,3	± 31	0	25	>3		2	3 ... 6	10	<12	150	

- ¹⁾ Doppeltransistor
- ²⁾ 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis)
- ³⁾ Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, getrennter Substratanschluß
- ¹⁾ dual transistor
- ²⁾ six-transistor MOS circuit
- ³⁾ dual transistor without gate protecting diodes with isolated bulk connexion

